

SPIS TREŚCI

	Strona
Przedmowa	5
J. Zarębski, D. Bisewski Modelowanie elektrotermicznych charakterystyk tranzystora MESFET w programie SPICE	9
J. Zarębski, J. Dąbrowski Wyznaczanie charakterystyk diody Schottky'ego z węgla krzemu z wykorzystaniem modelu elektrotermicznego	19
K. Górecki, J. Zarębski, K. Detka Modelowanie elementów magnetycznych w programie SPICE	31
K. Górecki, K. Detka Modelowanie charakterystyk rdzeni ferromagnetycznych	39
K. Górecki, P. Kural Podwodna latarka LED	52
E. Krac, K. Górecki Współczesne problemy energetyki solarnej	68
E. Raj Jednofazowe systemy chłodzenia cieczowego do zastosowań w elektronice	87
J. Chramiec Rezonatory ze skokową zmianą impedancji charakterystycznej do zastosowań w filtrach mikrofalowych	99
P. S. Dębicki Anizotropia ośrodków cienko uwarstwionych w odniesieniu do grzejnictwa mikrofalowego	113
H. Nowakowska, J. Mizeraczyk Rozkłady pola elektrycznego wewnątrz mikrofalowego źródła plazmy (MŹP) typu komora rezonansowa zasilana falowodowo	124
D. Czyłkowski, B. Hrycak, M. Jasiński, J. Mizeraczyk Badania eksperymentalne mikrofalowego generatora mikroplazmy małej mocy ...	137

	Strona
K. Garasz, R. Barbucha, M. Kocik, M. Tański, J. Mizeraczyk Prototypowe urządzenie laserowe do femtosekundowej mikroobróbki materiałów	149
M. Sobański, M. Lubański, M. Jasiński, M. Dors, J. Mizeraczyk Układ zastępczy i charakterystyki elektrodynamiczne mikrofalowego aplikatora plazmowego typu rezonator wnąkowy (915 MHz)	157
B. Hrycak, B. Miotk, M. Jasiński, M. Dors, M. Scapinello, J. Mizeraczyk Spektroskopowe badania wyładowania mikrofalowego w źródle plazmy typu komora rezonansowa zasilana falowodowo	169
R. Miotk, M. Jasiński, J. Mizeraczyk Wyładowanie mikrofalowe (915 MHz) dużej mocy w argonie pod ciśnieniem atmosferycznym	181
M. Tański, R. Barbucha, M. Kocik, J. Mizeraczyk, N.V. Sabotinov, T. Petrov Obrazowanie plazmy ablacyjnej generowanej nanosekundowymi impulsami laserowymi za pomocą kamery ICCD z szybką migawką optoelektroniczną	193
W.J. Stepowicz Wpływ promieniowania jonizującego na elementy półprzewodnikowe i układy scalone	201